

# 关于全国创新争先奖拟推荐对象的公示

根据《人力资源社会保障部 中国科协 科技部 国务院国资委关于评选全国创新争先奖的通知》(人社部函〔2017〕47号)要求,拟推荐王曦、卜智勇等为全国创新争先奖先进个人。

现对拟推荐对象进行公示,公示期为5个工作日(2017年4月27日至2017年5月4日)。

公示期间,对公示的拟推荐对象如有不同意见,请以书面形式,实名向党政办主任兼监察审计处处长张帆同志反映(电话:62511070-5806)。反映情况须客观真实,以单位名义反映情况的材料需加盖单位公章,以个人名义反映情况的材料应署实名并提供有效的联系方式。

## 先进个人:

序号	姓 名	工作单位和职务
1	王 曦	中科院上海微系统所 所长
2	卜智勇	中科院上海微系统所 第六实验室主任

附件:拟推荐对象基本情况和主要成绩、贡献

中国科学院上海微系统与信息技术研究所

2017年4月27日

## 附件 1：王曦院士推荐材料

### 一、学习经历

起止年月	校（院）及系名称	专业	学位
1983.09-1987.07	清华大学 工程物理系	材料科学	学士
1987.09-1990.05	中国科学院上海冶金研究所	材料物理	硕士
1990.09-1993.02	中国科学院上海冶金研究所	材料物理	博士

### 二、主要工作经历

起止年月	工作单位	职务/职称
1993.07-1994.05	澳大利亚联邦科学与工业研究院	访问学者/助理研究
1994.06-1996.04	中国科学院上海冶金研究所	重点实验室副主任/ 副研究员
1996.05-1998.06	德国 Rossendorf 研究中心	“洪堡”研究员/副研究 员
1998.07-2004.03	中国科学院上海微系统与信息技术研 究所	所长助理/研究员
2004.04-2010.06	中国科学院上海微系统与信息技术研 究所	副所长、党委书记/研 究员、中科院院士 (2009)
2010.07 至今	中国科学院上海微系统与信息技术研 究所	所长/研究员、中科院 院士

### 三、国内外重要社会任（兼）职

起止年月	名 称	职务/职称
2016.06 至今	中国科学技术协会	副主席
2010.08-2015.08	全国青年联合会（科学技术界别工作委员会）	副主席（主任委员）
2007.01 至今	国家科技重大专项“极大规模集成电路制造技术及成套工艺”	副总师
2004.09 至今	Ion Beam Modification of Materials 国际会议	国际委员会委员
2015.12 至今	专用集成电路与系统国家重点实验室	学术委员会主任
2013.07 至今	信息功能材料国家重点实验室	学术委员会主任

## 四、主要成绩和突出贡献

（本栏目是评价候选人的重要依据，应详实、准确、客观地填写近 5 年内，在“科学研究、技术开发、重大装备和工程攻关”、“转化创业”、“科普及社会服务”所作出的主要成绩和突出贡献。限 1500 字以内）

王曦，中国科学院院士，我国著名半导体材料学专家，高端集成电路衬底材料的主要开拓者和领军人物。现为中国科学院上海微系统与信息技术研究所所长，中国科学技术协会副主席，国家科技重大专项“极大规模集成电路制造装备及成套工艺”技术副总师，上海市决策咨询委员会委员。

王曦院士长期致力于载能离子束与固体相互作用物理现象研究，并将研究成果应用于高端集成电路衬底材料 SOI (Silicon-on-insulator) 的开发，创建了我国唯一的 SOI 材料研发和生产基地—上海新傲科技股份有限公司，解决了我国航天电子器件急需 SOI 产品的“有无”问题。王曦院士带领团队突破超低剂量氧离子注入与超高温精密控制退火技术，开发出低成本高质量的超低剂量(SLD) SOI 工艺，在国际上独创了具有核心自主知识产权的注氧键合 Simbond-SOI 新技术，成功完成我国 8 英寸 SOI 材料产业化，产品出口西方发达国家，实现我国微电子材料的跨越式发展。此外，SOI 产品已应用于航天电子器件，为我国特殊领域核心元器件自主可控做出突出贡献。与此同时，王曦院士作为上海决策咨询委员会委员、国家科技重大专项 02 专项技术副总师，大力推动一批半导体高科技重大项目，其中 12 寸集成电路硅片项目有望填补我国大尺寸硅片产业空白，上海微技术工业研究院成为上海建设全球科创中心的“四梁八柱”，磁存储器（MRAM）项目将为我国参与新一代存储芯片产业全球竞争奠定基础。

王曦院士在国际学术期刊及学术会议上发表论文 400 余篇，申请发明专利 160 余项，其中国际专利 27 项。担任“离子束材料改性国际会议”国际咨询委员会委员（中国唯一的国际委员），牵头承担国家科技重大专项等项目，领衔国家自然科学基金委创新研究群体，担任中国传感器与物联网产业联盟理事长、集成电路材料产业技术创新战略联盟理事长。曾获国家科技进步一等奖 1 项（第一完成人）、何梁何利基金科学与技术进步奖、中国科学院杰出科技成就奖（第一完成人）、上海市科技进步一等奖（第一完成人）等奖项以及上海市领军人才、中国科学院杰出青年等荣誉称号。

## 五、重要成果列表

(根据推荐领域，分别填写候选人获得的重要科技奖项，发明专利，代表性论文和著作，重大装备和工程相关重要成果，转化创业成果，重大科技类社会化公共服务产品等，按照上述顺序填写，总计不超过 15 项。)

序号	基本信息	本人作用和主要贡献(限 100 字)
1.	成果名称：国家科学技术进步奖-高端硅基 SOI 材料研发和产业化； 类别名称：国家级； 获奖等级：一等奖； 排名：第一； 获奖年份：2006； 证书号码： 2006-J-214-1-01-D01； 主要合作者：林成鲁、张苗、等。	王曦院士领导创业团队，突破实现 SOI 材料产业化的技术难题，解决了我国 SOI 材料的“有无”问题，为我国特殊领域核心元器件的开发扫除了障碍。同时，实现 SOI 材料产业化，高端集成电路材料 SOI 晶圆出口国际著名半导体公司。
2.	成果名称：何梁何利基金科学与技术进步奖； 类别名称：国家级； 获奖等级：一等奖； 排名：第一； 获奖年份：2008； 证书号码：无； 主要合作者：独立获奖。	王曦院士阐明离子注入合成过程中的物理和化学物理现象，利用低温离子注入损伤增强扩散，开发了超低剂量注氧隔离 SOI 技术；独创了键合 SOI 厚膜技术；提高 SOI 材料抗总剂量加固水平，达到宇航级抗辐照元器件水平。
3.	成果名称：中国科学院杰出成就奖-高端硅基 SOI 材料研究团队； 类别名称：省部级（科学院）； 获奖等级：一等奖； 排名：第一；	王曦院士作为高端硅基 SOI 材料研究团队领头人，其主要贡献是实现 SOI 材料产业化的技术难题和超低剂量氧离子注入形成 SOI 的 SLD 新工

	<p>获奖年份：2007；</p> <p>证书号码：无；</p> <p>主要合作者：林成鲁、陈猛、等。</p>	<p>艺，在国际上独创了注氧键合 (Simbond)SOI 新技术，用离子束改性技术大幅度提高 SOI 材料抗辐射水平。</p>
4.	<p>成果名称：上海市领军人才；</p> <p>类别名称：省部级（上海市）；</p> <p>获奖等级：一等奖；</p> <p>排名：第一；</p> <p>获奖年份：2007；</p> <p>证书号码：无；</p> <p>主要合作者：独立获奖。</p>	<p>王曦院士创建了我国唯一的 SOI 材料研发和生产基地-上海新傲科技，解决国家 SOI 产品的“有无”问题。同时，建设上海微技术工业研究院；推动成立 12 寸集成电路大硅片研发生产基地，为上海科技发展做出了重要贡献。</p>
5.	<p>高端硅基 SOI 材料成果转化，解决国家 SOI 材料有无问题。</p>	<p>王曦院士 2000 年创立国内唯一 SOI 晶圆生产基地-上海新傲科技股份有限公司，并一直参与公司的全方面管理。公司已形成 SOI 晶圆生产能力 10 万/年，供货国内外知名半导体企业。同时，解决国内特种领域 SOI“有无”问题。</p>
6.	<p>推动成立 12 寸集成电路大硅片研发生产基地，填补国内产业空白。</p>	<p>硅片是生产集成电路的主要原材料，目前主要是 300mm 硅片，然而国内的产量几乎为零。王曦同志组织推动国内大硅片研发生产，投资成立上海新昇半导体科技有限公司，目前已产出 300mm 大硅片样片，亮相 2016</p>

		年上海工博会。
7.	创建上海科创中心“四梁八柱”之一的功能性平台-上海微技术工业研究院	王曦院士 2013 年创立上海微技术工业研究院，致力于“超越摩尔”技术和物联网应用的创新和产业化。结合中国“超越摩尔”产业发展的特点，已经成为上海科创中心“四梁八柱”之一，目标建设世界级半导体创新中心。
8.	<i>Nature Communications</i> , 7 (2016) 13204; <i>Nano Letters</i> , 16 (2016) 3160; <i>Advanced Functional Materials</i> 25 (2015) 1805; <i>Advanced Functional Materials</i> 25 (2015) 3666	王曦院士作为中国科学院上海微系统与信息技术研究所 SOI 研究团队学术带头人，前瞻性部署二维 SOI 材料研究方向，在石墨烯材料与半导体集成方面取得系列有影响力研究成果。
9.	<i>Nature Communications</i> , 6 (2015) 5957; <i>Nano Letters</i> , 17 (2017) 1552; <i>Physical Review Letters</i> , 16 (2011) 203903 <i>Nano Letters</i> , 15 (2015) 2055;	王曦院士作为中国科学院上海微系统与信息技术研究所 SOI 研究团队学术带头人，推动 SOI 技术应用于硅基光子学领域，在 SOI 基光源、光路操控、微波射频波形发生器等方面取得突破。
10.		
11.		
12.		
13.		
14.		

## 附件 2：卜智勇研究员推荐材料

### 一、学习经历

起止年月	校（院）及系名称	专业	学位
1989 年 9 月-1993 年 7 月	四川大学	工学	学士
1993 年 9 月-1996 年 7 月	四川大学	工学	硕士
1996 年 9 月-2000 年 1 月	东南大学	无线电	博士

### 二、主要工作经历

起止年月	工作单位	职务/职称
2000 年 1 月-2000 年 12 月	诺基亚移动电话公司	博士后
2001 年 1 月-2002 年 10 月	青岛海信通信有限公司	高级工程师
2002 年 10 月-至今	中科院上海微系统与信息技术研究所	研究员，博导， 历任上海无线通信研究中心常务副主任、宽带无线技术实验室主任、 所副总工程师
2006. 3-2010. 12. 30	上海瀚讯信息技术股份有限公司	创始人、总经理
2010. 12. 31-至今	上海瀚讯信息技术股份有限公司	董事长



### 三、国内外重要社会任（兼）职

起止年月	名 称	职务/职称
2012 年	上海科技大学教授	教授
2012 年 10 月	中国通信学会理事会理事	第七届理事会理事
2012 年 2 月	第十三届政协科学技术委员会副 主任	技术委员会副主任
2011 年 8 月	上海市通信学会理事会理事	第九届理事会理事
2008 年 12 月 -2011 年 12 月	北京邮电大学兼职教授	信息与通信工程学 院兼职教授
2014 年 12 月	中国科学技术大学兼职教授	信息科学技术学院 兼职教授

#### 四、重要成果列表

(根据推荐领域，分别填写候选人获得的重要科技奖项，发明专利，代表性论文和著作，重大装备和工程相关重要成果，转化创业成果，重大科技类社会化公共服务产品等，按照上述顺序填写，总计不超过 15 项。)

序号	基本信息	本人作用和主要贡献（限 100 字）
1.	政府特殊津贴证书	2015 年国务院颁发，表彰为我国工程技术事业做出的突出贡献
2.	上海市职工优秀技术创新成果一等奖	2011 年上海市总工会及上海市科委颁发，表彰在无线宽带快速组网关键技术及研究做出的创新成果
3.	上海市科学技术进步二等奖	2010 年上海市人民政府颁发，表彰在“复杂环境与机动应用的宽带无线接入系统”中取得的成果
4.	上海市科学技术进步三等奖	2005 年上海市人民政府颁发，表彰在“无线局域网高精度定位技术的多媒体业务推送技术研究”中取得的成果
5.	上海市领军人才	2006 年上海市人民政府颁发
6.	一种自适应切换方法和装置	授权日 2016.6.1, ZL201110346634.9, 卜智勇, 排名第二
7.	一种波束成形方法、基站和交通运输装置	授权日 2015.9.23, ZL201110346614.1, 卜智勇, 排名第二
8.	一种基于同态加密的数据保护方法和系统	授权日 2015.9.16, ZL201210545714.1, 卜智勇, 排名第二
9.	一种基于带状网络的自适应传输方法	授权日 2015.4.22, ZL201210109342.8, 卜智勇, 排名第三
10.	多普勒频率估计与补偿方法及系统	授权日 2013.2.6, ZL201010509750.3, 卜智勇, 排名第一
11.	一种分层软小区无线网络及其接入控制方法	授权日 2009.6.24, ZL200480043564.8, 卜智勇, 排名第二
12.	宽带无线通信科研成果的产业转化成果——上海瀚讯信息技术	公司创始人，2006 年任公司总经理，2011 年任公司董事长。公司 2016 年实现产值 3.2 亿元,净利润 4700 万元。

	股份有限公司	
13.		
14.		
15.		